

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB11 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per il settore concorsuale 09/E3 – ELETTRONICA (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 ELETTRONICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1919 del 30 maggio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 dell'11 giugno 2019, IV serie speciale – Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 5

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Marta BAGATIN

Giudizio sulla prova orale: la prova di lingua inglese è stata effettuata chiedendo alla candidata Marta Bagatin di descrivere uno dei lavori presentati in lingua inglese. La candidata ha mostrato piena padronanza della lingua inglese ed in particolare correttezza e precisione dei termini e delle espressioni utilizzate, e capacità di avvalersi di un vocabolario tecnico adeguato ai temi trattati.

Titoli

Categorie di titoli	Punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero	10
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero	5
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri	7
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi	4
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista	0
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	7
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	8
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240	2

Et nle 4

Punteggio totale titoli: 43

Pubblicazioni presentate

Marta Bagatin	Titolo Articolo	Anno di pubblicazione	Rivista	Punteggio
1	Annealing of Heavy-Ion Induced Floating Gate Errors: LET and Feature Size Dependence	2010	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
2	Single and Multiple Cell Upsets in 25-nm NAND Flash Memories	2013	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
3	Error Instability in Floating Gate Flash Memories Exposed to TID	2009	IEEE Transactions on Nuclear Science	5
4	Impact of NBTI Aging on the Single-Event Upset of SRAM Cells	2010	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
5	Effects of Heavy-Ion Irradiation on Vertical 3-D NAND Flash Memories	2018	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
6	Increase in the Heavy-Ion Upset Cross Section of Floating Gate Cells Previously Exposed to TID	2010	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
7	Sample-to-Sample Variability and Bit Errors Induced by Total Dose in Advanced NAND Flash Memories	2014	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
8	Temperature dependence of neutron-induced soft errors in SRAMs	2012	Microelectronics Reliability	4
9	Impact of Technology Scaling on the Heavy-Ion Upset Cross Section of Multi-Level Floating Gate Cells	2011	IEEE Transactions on Nuclear Science	5
10	TID Sensitivity of NAND Flash Memory Building Blocks	2009	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
11	Key Contributions to the Cross Section of NAND Flash Memories Irradiated With Heavy Ions	2008	IEEE Transactions on Nuclear Science	4
12	Space and terrestrial radiation effects in flash memories	2017	Semiconductor Science and Technology	4

Punteggio totale pubblicazioni: 50

Punteggio totale: 93

MB 
Et

Candidato Giovanni Antonio SALVATORE

Giudizio sulla prova orale: la prova di lingua inglese è stata effettuata chiedendo al candidato Giovanni Antonio Salvatore di descrivere uno dei lavori presentati in lingua inglese. Il candidato ha mostrato piena padronanza della lingua inglese ed in particolare correttezza e precisione dei termini e delle espressioni utilizzate, e capacità di avvalersi di un vocabolario tecnico adeguato ai temi trattati.

Titoli

Categorie di titoli	Punti
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero	10
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero	5
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri	7
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi	4
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista	1
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	6
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	5
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240	2

Punteggio totale titoli: 40

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and smaller initials 'ET' below it.

Pubblicazioni presentate

Giovanni A. Salvatore	Articolo	Anno di pubblicazione	Rivista	Punteggio
1	Modeling the Temperature Dependence of Fe-FET Static Characteristics Based on Landau's Theory	2011	IEEE Transactions on Electron Devices	4
2	Experimental confirmation of temperature dependent negative capacitance in ferroelectric field effect transistor	2012	Applied Physics Letters	4
3	Fabrication and Transfer of Flexible Few-Layers MoS ₂ Thin Film Transistors to Any Arbitrary Substrate	2013	ACS Nano	4
4	Wafer-scale design of lightweight and transparent electronics that wraps around hairs	2014	Nature Communications	5
5	Contact resistance and overlapping capacitance in flexible sub-micron long oxide thin- film transistors for above 100 MHz operation	2014	Applied Physics Letters	4
6	Wireless Microfluidic Systems for Programmed, Functional Transformation of Transient Electronic Devices	2015	Advanced Functional Materials	4
7	Battery-free, stretchable optoelectronic systems for wireless optical characterization of the skin	2016	Science Advances	4
8	Flexible a-IGZO Phototransistor for Instantaneous and Cumulative UV-Exposure Monitoring for Skin Health	2016	Advanced Electronic Materials	4
9	Flexible In-Ga-Zn-O-Based Circuits With Two and Three Metal Layers: Simulation and Fabrication Study	2016	IEEE Electron Device Letters	4
10	Biodegradable and Highly Deformable Temperature Sensors for the Internet of Things	2017	Advanced Functional Materials	4
11	Buckled Thin-Film Transistors and Circuits on Soft Elastomers for Stretchable Electronics	2017	Applied Materials and Interfaces	4
12	Lab-on-Skin: A Review of Flexible and Stretchable Electronics for Wearable Health Monitoring	2017	ACS Nano	5

Punteggio totale pubblicazioni: 50

Punteggio totale: 90

role
Et

La commissione individua quale candidato vincitore Marta Bagatin per la seguente motivazione:

i punteggi assegnati per curriculum, titoli e pubblicazioni sono risultati complessivamente più alti (Allegato E).

Padova, 5 novembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Gian-Franco Dalla Betta, Università degli Studi di Trento
Prof. Valerio Re, Università degli Studi di Bergamo
Prof. Enrico Zanoni Università degli Studi di Padova

Prof. Dalla Betta
Valerio Re
Enrico Zanoni